

AlGaN（铝镓氮）基短波长光电外延材料与装备

王军喜 研究员

时间：2024年3月28日（星期四） 13:00—14:30

地点：北京大学物理楼中312会议室

报告人简介 (About speaker):

王军喜，中国科学院半导体研究所研究员，博士生导师，国家“万人计划”“科技创新领军人才”，科技部中青年科技创新领军人才。北京市第三代半导体材料及应用工程技术研究中心主任，科技部国家重点研发计划项目负责人。长期从事氮化物 LED 材料与器件研究工作，获 2019 年度国家科技进步一等奖、2015 年度国家科技进步二等奖、2014 年度国家技术发明奖二等奖，2012年度北京市科学技术一等奖等奖项。

摘要 (Abstract) :

氮化物半导体材料在显示、照明、生命健康等领域有着广泛的应用前景，其中波长低于300纳米以下的AlGaN基光电材料是研究的热点之一。AlGaN材料在生长机理、外延装备等方面都与GaN材料有显著的不同。本报告聚焦短波长光电器件，讨论其材料特性、装备需求及未来的应用领域。

联系人 (Host): 陈志忠 zzchen@pku.edu.cn

北京大学物理学院凝聚态物理与材料物理所

